

In the Claims:

Please amend the claims as follows:

1. (Original) Verfahren zum Herstellen einer Schicht-Anordnung,

bei dem über einem Substrat mit einer Mehrzahl von elektrisch leitfähigen Strukturen und/oder über einem Teil der Oberfläche der elektrisch leitfähigen Strukturen eine Schicht aus Silizium-Sauerstoff-Stickstoff-haltigem Material mittels eines plasmaangeregten chemischen Gasphasenabscheide-Verfahrens gebildet wird, wobei

- Silizium-Material und Sauerstoff-Material mittels eines organischen Silizium-Precursormaterials zugeführt werden,
- während des Zuführens des organischen Silizium-Precursormaterials zusätzlich Stickstoff-Material zugeführt wird,
- die Schicht aus Silizium-Sauerstoff-Stickstoff-haltigem Material gebildet wird derart, dass zwischen den Leiterbahnen ein materialfreier Bereich verbleibt,
- die Schicht aus Silizium-Sauerstoff-Stickstoff-haltigem Material gebildet wird derart, dass sie zwischen 3 Atomprozent und 13 Atomprozent Wasserstoff aufweist;

bei dem auf der Schicht aus Silizium-Sauerstoff-Stickstoff-haltigem Material eine Zwischenschicht aus elektrisch isolierendem Material aufgebracht wird, und

bei dem selektiv auf der Zwischenschicht eine Deckschicht aufgebracht wird, mittels welcher der materialfreie Bereich zwischen den elektrisch leitfähigen Strukturen gegenüber der Umgebung versiegelt wird, so dass der materialfreie Bereich einen Hohlraum ausbildet.

2.-9. (Canceled)